

Приложение 4
к ОПОП ВО 18.03.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ,
профиль Химическая технология новых материалов

Рабочая программа дисциплины

Кристаллография

Закреплена за подразделением

Кафедра физического материаловедения

Направление подготовки

18.03.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Профиль

Химическая технология новых материалов

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану

144

Формы контроля в семестрах:

в том числе:

экзамен 4

аудиторные занятия

51

самостоятельная работа

57

часов на контроль

36

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	4 (2.2)		Итого	
Неделя	18			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	17	17	17	17
Лабораторные	34	34	34	34
Итого ауд.	51	51	51	51
Контактная работа	51	51	51	51
Сам. работа	57	57	57	57
Часы на контроль	36	36	36	36
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):

кфмн, ведущий эксперт, Дьяконова Наталья Павловна; старший преподаватель, Захарова Елена Александровна; к.ф.-м.н., доц., Савченко Елена Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

Кристаллография

Разработана в соответствии с ОС ВО НИТУ МИСИС

по направлению подготовки 18.03.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (приказ от 02.04.2021 г. № 119 о.в.)

Составлена на основании учебного плана:

18.03.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, 18.03.01-БХТ-25-1.plx профиль Химическая технология новых материалов, утвержденного Ученым советом НИТУ МИСИС в составе соответствующей ОПОП ВО 30.05.2024, протокол № 4-24

Утверждена в составе ОПОП ВО:

18.03.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, профиль Химическая технология новых материалов, утвержденной Ученым советом НИТУ МИСИС 30.05.2024, протокол № 4-24

Рабочая программа одобрена на заседании

Кафедра физического материаловедения

Протокол от 22.04.2024 г., №220.24.2-14

Руководитель подразделения Савченко Александр Григорьевич

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ	
1.1	Сформировать компетенции в соответствии с учебным планом, а также научить использовать теорию симметрии и метод кристаллографических проекций для описания и анализа структуры кристаллов; дать представление о структурах металлов и сплавов, соединений с металлической, ионной и ковалентной связью, о материалах с аморфной и квазикристаллической атомными структурами, а также научить применять полученные знания в профессиональной деятельности

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
	Блок ОП: Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Математика
2.1.2	Информатика и основы искусственного интеллекта
2.1.3	Инженерная и компьютерная графика
2.1.4	Химия
2.1.5	Аналитическая геометрия
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Технологии получения композиционных материалов
2.2.2	Нормы и правила оформления ВКР
2.2.3	Методы обработки статистических данных (анализ данных)
2.2.4	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.5	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.6	Моделирование химико-технологических процессов
2.2.7	Теория химической связи
2.2.8	Методы физико-химических исследований
2.2.9	Физико-химия полимеров
2.2.10	Процессы получения и обработки материалов
2.2.11	Научно-исследовательская работа
2.2.12	Физико-химия конденсированного состояния
2.2.13	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.14	Методы исследования материалов
2.2.15	Физические свойства твердых тел
2.2.16	Процессы и аппараты химической технологии
2.2.17	Термодинамика сложных систем
2.2.18	Научно-исследовательская работа
2.2.19	Оформление результатов научной деятельности
2.2.20	Метрология, стандартизация и технические измерения
2.2.21	Методы контроля и анализа веществ
2.2.22	Композиционные материалы: структура, свойства, применение
2.2.23	Компьютерные методы в физической химии
2.2.24	Методы исследования структуры и свойства композиционных материалов

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ	
ОПК-2: Способен использовать математические, физические, физико-химические, химические методы, применять знания фундаментальных наук для решения задач профессиональной деятельности	
Знать:	
ОПК-2-31 принципы исследования кристаллической структуры материала	
ОПК-2-32 Знать основные законы кристаллохимии и принципы кристаллофизики	
ОПК-2-33 Основные законы кристаллографии, элементы симметрии континуума и дисконтинуума; действие элементов симметрии кристаллических структур	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, умение анализировать процессы и системы с использованием соответствующих аналитических, вычислительных и экспериментальных методов, применять системный подход для решения поставленных задач	
Знать:	
УК-1-31 основные и перспективные направления развития кристаллографии	
УК-1-33 Основные классификации кристаллических структур, характеристики основных типов современных кристаллических и квазикристаллических атомных структур	
УК-1-32 аналитические и экспериментальные методы анализа кристаллических структур	
ОПК-2: Способен использовать математические, физические, физико-химические, химические методы, применять знания фундаментальных наук для решения задач профессиональной деятельности	
Уметь:	
ОПК-2-У1 рассчитывать параметры конкретных кристаллических структур, в том числе, с использованием компьютерных программ	

ОПК-2-У2 использовать математический аппарат кристаллографии
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, умение анализировать процессы и системы с использованием соответствующих аналитических, вычислительных и экспериментальных методов, применять системный подход для решения поставленных задач
Уметь:
УК-1-У2 использовать основные понятия и закономерности кристаллографии и кристаллохимии для обоснованного выбора характеристик структуры и состава, стехиометрии фаз, в том числе, аморфных и квазикристаллических, предназначенных для целей дальнейшего использования
УК-1-У1 пользоваться справочной литературой
ОПК-2: Способен использовать математические, физические, физико-химические, химические методы, применять знания фундаментальных наук для решения задач профессиональной деятельности
Владеть:
ОПК-2-В2 использования в исследованиях и расчетах методов и подходов кристаллографии и кристаллохимии к описанию и анализу структуры кристаллов (в том числе методами кристаллографических проекций, индирования плоскостей и направлений в кристаллах)
ОПК-2-В1 Навыками исследования сложных кристаллических структур и структур с отсутствием трансляционной симметрии
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, умение анализировать процессы и системы с использованием соответствующих аналитических, вычислительных и экспериментальных методов, применять системный подход для решения поставленных задач
Владеть:
УК-1-В1 сбора данных, в том числе, из международных баз, и поиска информации об отдельных определениях, понятиях и терминах: о пространственной группе и структурном типе конкретной фазы для представления по ним ее симметрии и кристаллохимических характеристик

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ								
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Формируемые индикаторы компетенций	Литература и эл. ресурсы	Примечание	КМ	Выполняемые работы
	Раздел 1. Подготовка к контрольным мероприятиям и выполняемым работам							
1.1	/Ср/	4	0					
	Раздел 2. Геометрическая кристаллография							
2.1	Понятие кристалла. Пространственная решетка. Элементарная ячейка. Сингонии. Элементы симметрии многогранников (континуума)Теоремы сложения элементов симметрии многогранников. Определяющие элементы симметрии. Правила установки кристаллов /Лек/	4	3	УК-1-31 ОПК-2-У2 УК-1-В1 ОПК-2-33	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Э1			
2.2	Точечные группы (классы) симметрии. Принцип вывода 32 классов симметрии Главные направления. /Лек/	4	2	УК-1-31 ОПК-2-У2 УК-1-В1 ОПК-2-33	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э1			
2.3	Элементы симметрии кристаллических структур (дисконтинуума). Системы трансляций Бравэ. Базис. /Лек/	4	2	УК-1-31 УК-1-В1 ОПК-2-33	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э1 Э4 Э5			
2.4	Пространственные группы симметрии.Правильные системы точек. Международные кристаллографические таблицы. /Лек/	4	2	ОПК-2-31 УК-1-31 УК-1-В1 ОПК-2-33 УК-1-33	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э1			
2.5	Кристаллографические проекции /Лаб/	4	2	ОПК-2-У2	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э1			Р1

				ОПК-2-В2				
2.6	Индексы плоскостей и направлений. Межплоскостное расстояние, совокупность плоскостей. Кристаллографические зоны, условие зональности. /Лаб/	4	4	ОПК-2-У2 ОПК-2-В2	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э1		КМ1	Р2,Р10
2.7	Стандартные проекции, принцип их построения. /Лаб/	4	2	ОПК-2-У2 ОПК-2-В2	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э1			Р3
2.8	Определение класса симметрии по моделям многогранников. /Лаб/	4	4	УК-1-32 ОПК-2-33	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э1 Э4		КМ2	Р4
2.9	Выбор элементарной ячейки кристаллических структур. Определение периодов решетки и осевых углов. Определение системы трансляций Бравэ. Определение пространственной группы симметрии по моделям кристалла. Определение базиса кристаллической структуры и правильных систем точек с помощью Международных кристаллографических таблиц /Лаб/	4	8	УК-1-32 УК-1-В1 ОПК-2-33	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э1 Э4		КМ3	Р5
2.10	Подготовка к лабораторным занятиям и защите лабораторных работ по разделу "Геометрическая кристаллография" /Ср/	4	10	УК-1-31 УК-1-У1 ОПК-2-33 ОПК-2-У2	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э1			
2.11	Подготовка к контрольной работе №1 Тема: Кристаллографические проекции. Индексы плоскостей и направлений. /Ср/	4	2	УК-1-У1 ОПК-2-В2	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э1			
2.12	Выполнение домашнего задания 1 Тема: Геометрическая кристаллография. /Ср/	4	4	ОПК-2-В2 ОПК-2-У2	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э1			
2.13	Подготовка к контрольной работе №2 Тема: Классы симметрии. Пространственные группы. Базис. /Ср/	4	2	ОПК-2-33 ОПК-2-У2	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э1			
	Раздел 3. Основы кристаллохимии							
3.1	Типы химической связи в кристаллах. Атомные и ионные радиусы. Координационные числа и многогранники. Плотнейшие шаровые упаковки. Типы пустот (пор) и мотивы их заполнения. Типичные плоские сетки. /Лек/	4	2	ОПК-2-31 УК-1-31 УК-1-У2 ОПК-2-32	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э1 Э4 Э5			
3.2	Структурный тип. Стандартная информация о структурном типе. Классификация структурных типов.	4	2	УК-1-31 УК-1-У1 УК-1-У2 УК-1-33 ОПК-	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э1 Э3 Э4 Э5			

	Основные структуры химических элементов. Основные структуры соединений с металлической, ионной и ковалентной связью /Лек/			2-32				
3.3	Анализ основных структурных типов металлических элементов (A1, A2, A3,) /Лаб/	4	2	УК-1-32 УК-1-У1 УК-1-У2 УК-1-В1	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э4 Э5			P6
3.4	Кристаллографический и кристаллохимический анализ моделей кристаллических структур химических элементов и соединений с металлической, ионной и ковалентной связью. /Лаб/	4	6	УК-1-32 УК-1-У1 УК-1-У2 ОПК-2-32	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э3 Э4 Э5			P7
3.5	Подготовка к лабораторным занятиям и к защите лабораторных работ по разделу "Основы кристаллохимии" /Ср/	4	8	УК-1-32 УК-1-У2 УК-1-У1 ОПК-2-32	Л1.1Л2.1 Л2.2			
3.6	Выполнение домашнего задания №2 Тема: Кристаллохимический анализ модели. /Ср/	4	8	УК-1-32 УК-1-У1 УК-1-У2 УК-1-В1	Л1.1Л2.1 Л2.2 Э4 Э5			
	Раздел 4. Основы кристаллофизики							
4.1	Элементы кристаллофизики. /Лек/	4	2	ОПК-2-31 УК-1-31 ОПК-2-32	Л1.1Л2.1 Э1			
4.2	Принцип суперпозиции Кюри. Изменение симметрии кристалла в результате внешних воздействий. /Лаб/	4	4	УК-1-32 ОПК-2-32	Л1.1Л2.1 Э1 Э5		КМ4	P8
4.3	Подготовка к лабораторным занятиям и защите лабораторных работ по разделу "Основы кристаллофизики" /Ср/	4	2	УК-1-31 УК-1-32 ОПК-2-32	Л1.1Л2.1 Э1 Э5			
4.4	Подготовка к контрольной работе №3. Тема: Основы кристаллохимии и кристаллофизики. /Ср/	4	2	УК-1-32 ОПК-2-32	Л1.1Л2.1 Э1			
	Раздел 5. Основные характеристики структур с полным или частичным отсутствием трансляционной симметрии							
5.1	Аморфные твердые тела. Нанокристаллы. Квазикристаллы. Жидкие кристаллы /Лек/	4	2	ОПК-2-В1 УК-1-31 УК-1-У2 УК-1-33	Л1.1Л2.1Л3.1 Э1 Э2			
5.2	Описание структуры аморфных тел. /Лаб/	4	2	УК-1-У1 УК-1-У2 УК-1-В1	Л1.1Л2.1Л3.1 Э3 Э4			P9
5.3	Подготовка к лабораторной работе "Описание структуры аморфных тел" /Ср/	4	1	ОПК-2-В1 УК-1-У2	Л1.1Л2.1Л3.1 Э3 Э4			
5.4	подготовка к экзамену по курсу /Ср/	4	18	ОПК-2-31 ОПК-2-У1 УК-1-31 ОПК-2-В1 УК-1-32 УК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э3 Э5		КМ5	

				УК-1-У2 УК-1-В1 УК-1-33 ОПК-2-32 ОПК-2-33 ОПК-2-У2 ОПК-2-В2				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.1. Контрольные мероприятия (контрольная работа, тест, коллоквиум, экзамен и т.п), вопросы для самостоятельной подготовки

Код КМ	Контрольное мероприятие	Проверяемые индикаторы компетенций	Вопросы для подготовки
КМ1	Контрольная работа 1 «Кристаллографические проекции. Индексы плоскостей и направлений»	УК-1-У1;ОПК-2-33;ОПК-2-У2;ОПК-2-В2	1 Опишите принцип построения кристаллографических проекций? 2 Какие бывают комплексы? 3 Как получить гномостереографическую проекцию? 4 Как получить стереографическую проекцию? 5 Изобразите ГСП куба. 6 Что такое индексы плоскости? 7 Что такое индексы направления? 8 Дайте определение совокупности плоскостей. 9 Дайте определение зоне плоскостей. 10 Как рассчитать межплоскостное расстояние для заданной сингонии? 11 Напишите условие зональности. 12 Какие кристаллические системы Вы знаете? 13 Какие сингонии относятся к высшей, средней и низшей категориям? 14 Что такое стандартные проекции? 15 Для кристаллов каких сингоний можно построить стандартные проекции? 16 Укажите соотношения трансляций и углов для заданной сингонии. 17 Изобразите элементарную ячейку кристалла заданной сингонии? 18 Сколько плоскостей в совокупности для кристалла кубической сингонии? 19 Что произойдет с совокупностью, в случае понижения симметрии? 20 Как посчитать угол между двумя плоскостями?
КМ2	Тест "Теоремы сложения элементов симметрии"	ОПК-2-33	Теоремы сложения элементов симметрии континуума
КМ3	Контрольная работа 2 «Внешнее и внутреннее строение кристалла»	УК-1-32;УК-1-У1;УК-1-В1;ОПК-2-33;ОПК-2-У2;ОПК-2-В2	1 Что такое класс симметрии? 2 Как правильно записать пространственную группу? 3 Перечислите элементы симметрии континуума. 4 Что такое определяющий элемент симметрии? 5 Как действует заданный элемент симметрии? 6 Теоремы сложения элементов симметрии. 7 Укажите правила установки кристалла заданной сингонии. 8 Перечислите элементы симметрии дисконтинуума? 9 Главные направления. 10 Что такое базис? 11 Как правильно записать базис? 12 Как посчитать количество атомов на элементарную ячейку? 13 Что такое формула симметрии? 14 Что такое эпюра? 15 Как построить эпюру данного класса? 16 Какие типы решеток Бравэ Вы знаете? 17 Перечислите элементы симметрии со скольжением? 18 Перечислите элементы симметрии, не содержащие трансляций? 19 Какое положение точки на эпюре называется частным? 20 Какое положение точки на эпюре называется общим? 21 Перечислите принципы выбора элементарной ячейки. 22 Что такое правильная система точек? 23 Что такое кратность? 24 Как посчитать кратность элемента структуры?
КМ4	Контрольная работа 3 «Основы	УК-1-У2;УК-1-У1;ОПК-2-32	1 Какие типы химической связи бывают в кристаллах? 2 Что такое координационное число?

	кристаллохимии и кристаллофизики»		<p>3 Что такое координационный полиэдр?</p> <p>4 Как посчитать координационное число в структуре?</p> <p>5 Какие типы пустот бывают?</p> <p>6 Какие упаковки называются плотнейшими?</p> <p>7 Какие типы пустот бывают в плотнейших упаковках?</p> <p>8 Как посчитать количество пор в структуре?</p> <p>9 Что такое структурный тип?</p> <p>10 Классификация структурных типов.</p> <p>11 Опишите структурный тип (A1, A2, A3, B1, B2, C1)</p> <p>12 От чего зависит радиус атома?</p> <p>13 Как посчитать радиус атома в заданной структуре?</p> <p>14 Что такое предел устойчивости структуры?</p> <p>15 Как посчитать объём элементарной ячейки?</p> <p>16 Что показывает коэффициент заполнения?</p> <p>17 Как посчитать коэффициент компактности?</p> <p>18 Как правильно записать Пирсон код.</p> <p>19 Как изменится симметрия кристалла после внешнего воздействия?</p>
КМ5	Экзамен по курсу	УК-1-32;УК-1-У1;УК-1-У2;УК-1-В1;ОПК-2-32;ОПК-2-33;ОПК-2-У1;ОПК-2-У2;ОПК-2-В2	<p>Индексы плоскостей и направлений;</p> <p>Зона плоскостей, уравнение зональности;</p> <p>Межплоскостное расстояние, совокупность плоскостей;</p> <p>Элементарная ячейка;</p> <p>Категория, сингония, кристаллическая система;</p> <p>Элементы симметрии внешней формы кристалла (континуума);</p> <p>Определяющие элементы симметрии;</p> <p>Правила установки кристаллов;</p> <p>Теоремы сложения элементов симметрии;</p> <p>Понятие класса симметрии (точечная группа);</p> <p>Главные направления кристалла;</p> <p>Системы трансляций Бравэ;</p> <p>Особенности элементов симметрии внутреннего строения кристаллов;</p> <p>Пространственные группы, правильные системы точек;</p> <p>Понятие базиса;</p> <p>Плотнейшие шаровые упаковки;</p> <p>Типы пустот (пор) и мотивы их заполнения;</p> <p>Типы химической связи в кристаллах;</p> <p>Атомные и ионные радиусы;</p> <p>Координационные числа и многогранники;</p> <p>Идеальная плотность заполнения;</p> <p>Стандартная информация о структурном типе. Классификация структурных типов;</p> <p>Структурный тип (знать A1, A2, A3, B1, B2);</p> <p>Размерный фактор;</p> <p>Пирсон символ код;</p> <p>Элементы кристаллофизики;</p> <p>Предельные группы симметрии;</p> <p>Проекция кристаллов (СП, ГСП). Комплексы (полярный, кристаллический)</p> <p>Задачи:</p> <p>Используя теоремы сложения построить эпюру, определить класс симметрии.</p> <p>По базису изобразить эл.ячейку. Определить тип решетки Бравэ, стехиометрию соединения.</p> <p>По пространственной группе определить сингонию кристалла, точечную группу.</p> <p>Определить стехиометрию кристалла, зная количество и тип занимаемых пор.</p> <p>Как изменится симметрия кристалла в результате внешнего воздействия?</p>
5.2. Перечень работ, выполняемых по дисциплине (Курсовая работа, Курсовой проект, РГР, Реферат, ЛР, ПР и т.п.)			
Код работы	Название работы	Проверяемые индикаторы компетенций	Содержание работы
P1	Лабораторная работа 1 Кристаллографические проекции	ОПК-2-В2	Стереографические и гномоцентрические проекции. Принципы их построения. Решение задач с использованием сетки Вульфа.
P2	Лабораторная работа 2 Основные понятия и математический	ОПК-2-У2;ОПК-2-В2	Индексы плоскостей и направлений. Межплоскостное расстояние, совокупность плоскостей. Кристаллографические зоны, условие зональности.

	аппарат кристаллографии		
P3	Лабораторная работа 3 Стандартные проекции.	ОПК-2-B2;УК-1-У1	Построение стандартной проекции для кристалла кубической сингонии с заданной осью проекции.
P4	Лабораторная работа 4 Классы симметрии.	УК-1-B1;ОПК-2-33	Определение класса симметрии по моделям многогранников (низшая/средняя категория + высшая категория)
P5	Лабораторная работа 5 Пространственные группы	УК-1-B1;ОПК-2-33	Выбор элементарной ячейки кристаллических структур. Определение периодов решетки и осевых углов. Определение системы трансляций Бравэ. Определение пространственной группы симметрии по моделям кристалла. Определение базиса кристаллической структуры и правильных систем точек с помощью Международных кристаллографических таблиц
P6	Лабораторная работа 6 Основные структурные типы металлов.	УК-1-32;УК-1-У1;УК-1-У2;УК-1-B1;УК-1-33	Анализ основных структурных типов металлических элементов (A1, A2, A3.)
P7	Лабораторная работа 7 Кристаллохимический анализ моделей кристаллических структур.	УК-1-32;УК-1-У2;УК-1-B1;ОПК-2-32	Кристаллографический и кристаллохимический анализ моделей кристаллических структур химических элементов и соединений с металлической, ионной и ковалентной связью. Определение типа связи, коэффициента заполнения, типа и количества пор, слоистости, устойчивости структуры.
P8	Лабораторная работа 8 Основы кристаллофизики	УК-1-У1;ОПК-2-32	Принцип суперпозиции Кюри. Изменение симметрии кристалла в результате внешних воздействий.
P9	Лабораторная работа 9 Описание структуры аморфных тел.	УК-1-У2;УК-1-33	С помощью двухмерного моделирования описать структуру вещества, находящегося в аморфном состоянии. Рассчитать степень ближнего порядка.
P10	Домашнее задание 1 Геометрическая кристаллография	ОПК-2-B2;ОПК-2-У2	Решение задач по геометрической кристаллографии
P11	Домашнее задание 2 Кристаллографический и кристаллохимический разбор модели	УК-1-У2;УК-1-B1;УК-1-32;ОПК-2-32;ОПК-2-31;ОПК-2-33	По модели кристаллической решетки провести кристаллографический и кристаллохимический анализ.

5.3. Оценочные материалы, используемые для экзамена (билеты, тесты и т.п.)

Экзаменационный билет состоит из теоретических вопросов и задач. Пример вопросов приведен в разделе Вопросы для самостоятельной подготовки к экзамену.

5.4. Методика оценки освоения дисциплины (модуля, практики. НИР)

Оценка «отлично» - обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнительно рекомендованную литературу. Оценка «хорошо» - обучающийся показывает твердые и достаточно полные знания в объеме пройденной программы, допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, правильно действует по применению знаний на практике, четко излагает материал.

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся показывает знания в объеме пройденной программы, ответы излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов, правильно действует по применению знаний на практике;

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы

Оценка «не явка» – обучающийся не явился на контрольные мероприятия в семестре.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л1.1	Уманский Я. С., Скаков Ю. А., Иванов А. Н., Расторгуев Л. Н.	Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия: Учебник для вузов	Библиотека МИСиС	М.: Металлургия, 1982
Л1.2	Горелик С. С., Скаков Ю. А., Расторгуев Л. Н.	Рентгенографический и электронно-оптический анализ: практ. рук. по рентгенографии, электронографии и электрон.	Библиотека МИСиС	М.: Металлургия, 1970

		микроскопии металлов, полупроводников и диэлектриков: Учеб. пособие для вузов		
Л1.3	Горелик С. С., Скаков Ю. А., Расторгуев Л. Н.	Рентгенографический и электронно-оптический анализ: приложения: Учеб. пособие для вузов	Библиотека МИСиС	М.: Металлургия, 1970
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л2.1	Шаскольская М. П.	Кристаллография: учеб. пособие для студ. высш. техн. учеб. заведений	Библиотека МИСиС	М.: Высш. шк., 1984
Л2.2	Новиков И. И., Розин К. М.	Кристаллография и дефекты кристаллической решетки: Учебник для вузов	Библиотека МИСиС	М.: Металлургия, 1990
Л2.3	Розин К. М.	Практическая кристаллография: учеб. пособие для студ. вузов напр. 150700(651800)-Физическое материаловедение и 150100 (651300)-Металлургия	Электронная библиотека	М.: Изд-во МИСиС, 2005
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л3.1	Ягодкин Юрий Дмитриевич, Свиридова Татьяна Александровна	Атомное строение фаз. Кристаллохимия твердых растворов и промежуточных фаз. Структура аморфных, квазикристаллических и нанокристаллических материалов: курс лекций для студ. спец. - 'Физика металлов' и 'Наноматериалы'	Электронная библиотека	М.: Учеба, 2007
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
Э1	Научная электронная библиотека eLIBRARY		http://elibrary.ru/	
Э2	РЕСУРСЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА Springer Nano -ресурс содержит информацию о наноматериалах и наноустройствах		http://nano.nature.com/	
Э3	International Centre for Diffraction Data		http://www.icdd.com/	
Э4	Inorganic Crystal Structure Database:		http://www.fiz-karlsruhe.de/icsd.html	
Э5	International Union of CRYSTALLOGRAPHY:		http://www.iucr.org/resources/data	
6.3 Перечень программного обеспечения				
П.1	MS Teams			
П.2	LMS Moodle			
П.3	Microsoft Office			
П.4	Лицензии ПО Windows Server CAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL, ПО WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr и PerUsr			
П.5	ESET NOD32 Antivirus			
6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных				
И.1	International Union of CRYSTALLOGRAPHY: http://www.iucr.org/resources/data			
И.2	Полнотекстовые российские научные журналы и статьи:			
И.3	Научная электронная библиотека eLIBRARY https://elibrary.ru/			
И.4	Иностранные базы данных (доступ с IP адресов МИСиС):			
И.5	аналитическая база (индексы цитирования) Scopus https://www.scopus.com/			
И.6	научометрическая система InCites https://apps.webofknowledge.com			
И.7	SpringLink https://link.springer.com/			
И.8	Электронная библиотека МИСиС http://elibrary.misis.ru/			
И.9	ЭБС "Лань" https://e.lanbook.com			
И.10	Электронный фонд https://docs.cntd.ru/?ysclid=lp5ebi7lkx985720114			
И.11	Подписки на базы данных в НИТУ МИСИС https://research.misis.ru/library			
И.12	https://www.studentlibrary.ru/ru/pages/catalogue.html			
И.13	http://humbio.ru/humbio/physiology/0005e445.htm			
И.14	https://booksmed.info/			
И.15	https://openedu.ru/			

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ		
Ауд.	Назначение	Оснащение
К-311	Лекционная аудитория	комплект учебной мебели на 118 рабочих мест, рабочее место преподавателя с персональным компьютером
Б-413	Учебная аудитория	проектор; мультимедийная доска; маркерная доска, документ-камера; компьютер преподавателя; компьютерный класс на 14 компьютеров, пакет лицензионных программ MS Office, комплект учебной мебели
Читальный зал электронных изданий	Аудитория для самостоятельной работы	комплект учебной мебели на 55 мест для обучающихся, 50 ПК с доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Moodle
Читальный зал № 3 (Б)	Аудитория для самостоятельной работы	комплект учебной мебели на 44 места для обучающихся, МФУ Xerox VersaLink B7025 с функцией масштабирования текстов и изображений, 8 ПК с доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Moodle

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
<p>Практические занятия нацелены на изучение студентами общих вопросов геометрической кристаллографии и кристаллохимии. Лабораторные работы нацелены на практическое изучение симметрии кристаллов, анализа структурных типов, построение кристаллографических проекций.</p> <p>Предусматриваются расчетные домашние задания по различным разделам курса. Проведение аудиторных занятий предусматривает использование в учебном курсе активных и интерактивных технологий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение практических и лабораторных занятий с использованием интерактивных и мультимедийных технологий (презентация в формате MS PowerPoint); - использование парка моделей структур и моделей внешней формы кристаллов. <p>Обучение организуется в соответствии с настоящей программой. Самостоятельная работа студентов организуется и контролируется путем индивидуального опроса студентов во время лабораторных занятий, проведения трех письменных контрольных работ и двух домашних заданий. Рекомендуется на каждом практическом занятии и лабораторной работе проводить экспресс опрос с целью установления усвояемости дисциплины.</p> <p>Перед началом занятий студенты получают на текущий семестр календарный план проведения лабораторных занятий и контрольных работ, график выдачи и сдачи домашних заданий.</p> <p>Для успешного освоения изучаемой дисциплины для студентов организуются еженедельные консультации.</p>